

M1FL40**400V 1.5A****特長**

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr=50ns

Feature

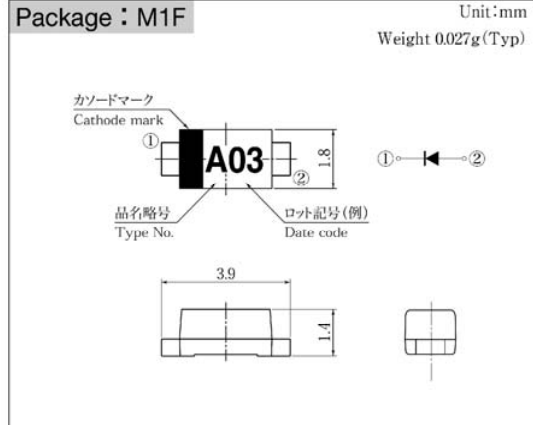
- Small SMD
- Low Noise
- trr=50ns

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

■外観図 OUTLINE

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

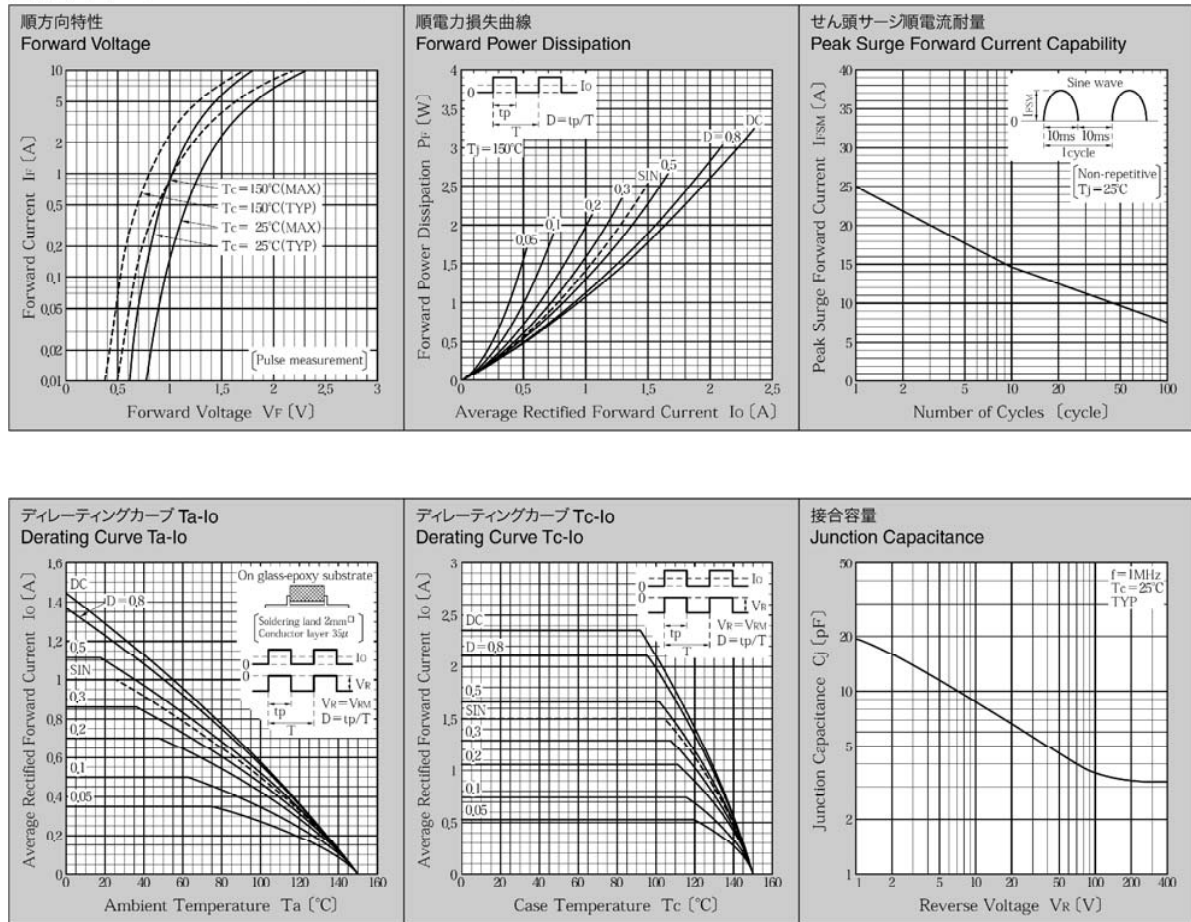
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M1FL40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	プリント基板実装 $T_a = 25^\circ\text{C}$ On glass-epoxy substrate $T_a = 25^\circ\text{C}$	1.0	A
			$T_c = 104^\circ\text{C}$	1.5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		25	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 1A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1.0A	MAX 50	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 9	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 20	℃/W
	θ_{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 80	
	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 18	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.